

PBSS304PX

60 V, 4.2 PNP低V CESAT (BISS) 晶体管

牧师02 - 2009年12月8日

产品数据表

1. 产品廓

1.1 概述

PNP低V CESAT突破性小信号 (BISS) 在SOT89晶体管 (SC-62 / TO-243) 小型和扁平的铅表面贴装器件 (SMD) 塑料封装。

NPN补充: PBSS304NX。

1.2 产品特点

低集电极 - 发射极饱和电压 $V_{CE(sat)}$
 高集电极电流能力 I_C
 高集电极电流增益 (HFE) 在高 I_C
 高英法效率由于较少的热量产生
 较小的所需的印刷电路板 (PCB) 面积比传统的晶体管

1.3 应用

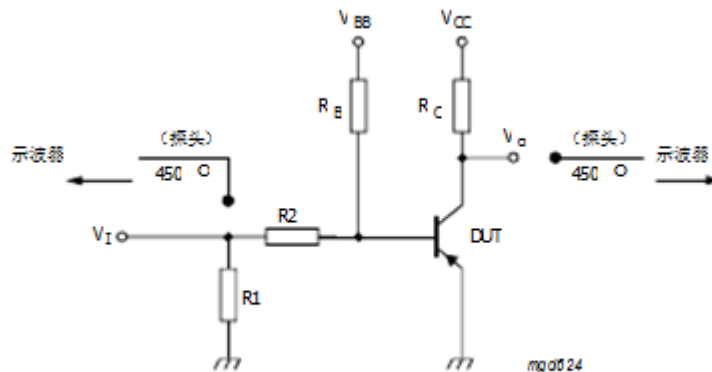
高压的DC-DC变换
 高压MOSFET栅极驱动
 高压电机控制
 高压功率开关 (如电机, 风机)
 汽车应用

1.4 快速参考数据


表1中。快速参考数据

符号	参数	条件	民	典型值	最大	单位
$V_{CE(sat)}$	集电极 - 发射极电压	开基	-	-	-60	V
I_C	集电极电流		-	-	-4.2	A
I_{CM}	峰值集电极电流	单脉冲; $t_p = 1$ 毫秒	-	-	-8.4	A
R_{CESAT}	集电极 - 发射极饱和 阻力	$I_C = -4$ A; $I_E = -200$ mA	[1]	48	69	mΩ

[1] 脉冲测试: $t_{on} = 300$ μs; $\delta = 0.02$.



$$V_{CC} = -12.5 \text{ V}; I_{E(on)} = -3 \text{ A}; I_{E(off)} = -0.15 \text{ A}; I_{C(on)} = 0.15 \text{ A}$$

针	描述	简化的轮廓
1	辐射源	
2	集热器	
3	BASE	

